Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: GIÁO SƯ
Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☑; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☑; Giảng viên thỉnh giảng ☐
Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Đỗ Văn Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 20/02/1980; Nam ☑; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☑
4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Căn hộ N03T7, toà nhà NO3T7, khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ N03T7, toà nhà NO3T7, khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội
Điện thoại nhà riêng: không có; Điện thoại di động: 0904158559;
E-mail: nam.dovan@phenikaa-uni.edu.vn
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Từ 04/2002 đến 09/2004: Giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Từ 10/2004 đến 12/2007: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Paris XI
Từ 02/2008 đến 02/2009: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện điện tử cơ bản (IEF), CNRS, Trường Đại học Paris XI
Từ 09/2009 đến 06/2018: Giảng viên, Phó viện trưởng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội)
Từ 07/2018 đến 12/2023: Giảng viên, Viện trưởng tại Trường Đại học Phenikaa
Từ 01/2024 đến 06/2024: Giảng viên tại Trường Đại học Phenikaa
Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng
Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Phenikaa
Địa chỉ cơ quan: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 024 6291 8118
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 20 tháng 07 năm 2001, số văn bằng: B321766, ngành: Vật lí, chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 26 tháng 02 năm 2004, số văn bằng: A010100, ngành: Vật lí, chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Được cấp bằng TS [5] ngày 27 tháng 02 năm 2008, số văn bằng: PARXI6411976, ngành: Vật lí, chuyên ngành: Vật lí điện tử

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Paris XI, CH Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 10 tháng 10 năm 2016, ngành: Vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Phenikaa

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Vận chuyển điện lượng tử trong vật liệu và linh kiện bán dẫn.
- Tính chất điện tử, quang học và topo của các vật liệu van der Waals hai chiều.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ;
- Đã công bố (số lượng) 38 bài báo khoa học, trong đó 34 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Bằng khen của Bộ trưởng	Bộ Giáo Dục và Đào Tạo	2015
2	Bằng khen của Bộ trưởng	Bộ Khoa học và Công nghệ	2016
3	Bằng khen Giải thưởng Nghiên cứu trẻ	Hội Vật lí lí thuyết Việt Nam	2013

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Tiêu chuẩn của nhà giáo:

1. **Phẩm chất và đạo đức:** Có tư tưởng, phẩm chất và đạo đức tốt.
2. **Trình độ chuyên môn:** Đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.
3. **Lý lịch và sức khỏe:** Lý lịch rõ ràng và sức khỏe tốt.
4. **Kỹ năng ngoại ngữ và tin học:** Thành thạo ngoại ngữ và tin học để cập nhật và nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhiệm vụ của nhà giáo:

1. **Giảng dạy và đào tạo:** Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.
2. **Thực hiện nghĩa vụ công dân:** Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật và quy chế nhà trường.
3. **Giữ gìn phẩm chất:** Giữ gìn phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo.
4. **Đối xử với người học:** Tôn trọng và đối xử công bằng với người học, bảo vệ quyền và lợi ích của họ.
5. **Học hỏi và cập nhật kiến thức:** Không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới.
6. **Nghiên cứu khoa học:** Cập nhật hướng nghiên cứu mới để đạt kết quả phù hợp với xu thế phát triển khoa học.
7. **Liêm chính trong nghiên cứu:** Đề cao sự liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

Tự đánh giá:

Tôi tự đánh giá rằng mình đáp ứng tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo Luật Giáo dục và tiêu chuẩn chức danh Giáo sư do Nhà nước quy định.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm 8 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/ BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	**Phụ**			**ĐH**	**SĐH**	
1								
2								
3								
03 năm học cuối								
4	2021-2022					270		270/300/175,5
5	2022-2023					285		285/380,7/175,5
6	2023-2024					495		495/565,5/222,8

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày

15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☑:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm
- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☑ hoặc TSKH ☐; Tại nước: CH Pháp năm 2007

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Lê Hoàng Anh	X		X		04/2011 đến 12/2014	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	16/12/2015
2	Hồ Sỹ Tá	X		X		10/2011 đến 10/2015	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	09/08/2017

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)

Sau khi được công nhận PGS/TS							
1	Tính toán vận chuyển điện lượng tử trong vật liệu và linh kiện nano – Cơ sở của gói mô phỏng OPEDEVS	CK	Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, năm 2024	1	MM		QĐ số 1347/QĐ-ĐHP-ĐT ngày 12/6/2024

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Trước khi được công nhận PGS/TS					
1	Nghiên cứu thực nghiệm và lí thuyết về vật liệu và linh kiện điện tử/quang tử dựa trên các màng bán dẫn ZnO pha tạp carbon và các màng tinh thể carbon đơn lớp thuần tuý (graphene)	CN	103-02-64-09 Đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ, cấp Bộ	01/12/2009 đến 01/12/2012	Biên bản thanh lí hợp đồng ngày 31/12/2013. Kết quả: Đạt
2	Xây dựng và phát triển chương trình mã nguồn mở OPEDEVS cho phép mô phỏng hoạt động và nghiên cứu các tính chất vật lý lượng tử của các cấu trúc linh kiện và vật liệu quang/điện tử kích thước nanomet	CN	B2012-01-29 Đề tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ, cấp Bộ	06/02/2012 đến 06/02/2014	Họp nghiệm thu ngày 20/08/2014. Kết quả: Xuất sắc
3	Nghiên cứu vai trò và tác động của các tiếp xúc kim loại lên các tính chất truyền dẫn điện của graphene	CN	103.01-2013.04 Đề tài do Quỹ Nanfosted tài trợ, cấp Bộ	01/03/2014 đến 01/03/2016	Biên bản nghiệm thu ngày 23/2/1016 Xếp loại: Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi được công nhận PGS/TS								
1	Transport and noise in resonant tunneling diode using self-consistent Green's function calculation	3	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN 0021-8979 (Print)	Có - ISI *IF: 2.634, Q2*	45	100 093705	11/2006
2	A study of quantum transport in end-of-roadmap DG-MOSFETs using a fully self-consistent Wigner Monte Carlo approach	5	Không	IEEE Transactions on Nanotechnology ISSN: 1941-0085	Có - ISI *IF: 2.966, Q1*	66	5 737	11/2006
3	An improved Wigner Monte-Carlo technique for the self-consistent simulation of RTSs	5	Không	Journal of Computational Electronics ISSN:1572-8137 (Online) ISSN: 1569-8025 (Print)	Có - ISI *IF: Q3*	57	5 443	12/2006
4	Fully quantum self-consistent study of ultimate DG-MOSFET's including realistic scattering using a Wigner MC approach	5	Không	IEDM Technical Digest ISSN 0163-1918 (Print)	Có	17	1 941	12/2006
	Effects of inelastic-							

5	scattering on the current-voltage and shot noise characteristics in resonant tunneling structures	3	Có	AIP coference proceedings ISBN 978-0-7354-0432-8, ISSN 0094-243X			325	09/2007
6	Shot noise in resonant tunneling structures using non-equilibrium Green's function calculation	3	Có	Journal of Computational Electronics ISSN:1572-8137 (Online) ISSN: 1569-8025 (Print)	Có - ISI *IF: Q3*	2	6 125	01/2007
7	Oscillation of gate leakage current in double-gate metal-oxide-semiconductor field-effect transistors	2	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN 0021-8979 (Print)	Có - ISI *IF: 2.3, Q2*	21	101 073709	04/2007
8	Phonon-induced shot noise in double barrier resonant tunneling structures	3	Có	Applied Physics Letters ISSN: 0003-6951 (Print) ISSN: 1077-3118 (Online)	Có *IF: 4.015, Q1*	14	91 022104	06/2007
9	Scattering approach to current and noise in interacting mesoscopic systems	3	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.324, Q1*		76 125309	09/2007
10	Wigner ensemble Monte-Carlo simulation of nano MOSFETs in degenerate conditions	5	Không	Physica Status Solidi C ISSN: 1610-1642 (online)	Có - Scopus *IF: Q3*	7	5 105	10/2007
11	Electronic transport and spin-polarization effects of relativistic-like	5	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN	Có *IF: 2.251, Q2*	92	104 063708	09/2008

	particle in mesoscpic graphene structures			0021-8979 (Print)				
12	Comment on "Negative differential conductance of electrons in graphene barrier" [Appl. Phys. Lett. 90.143111 (2007)	1	Có	Applied Physics Letters ISSN: 0003-6951 (Print) ISSN: 1077-3118 (Online)	Có - ISI *IF: 3.951, Q1*	8	92 216101	05/2008
13	Effects of charged impurities and lattice defects on transport properties of nanoscale graphene structures	2	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN 0021-8979 (Print)	Có - ISI *IF: 2.236, Q2*	12	106 023719	07/2009
14	Controllable spin-dependent transport in armchair graphene nanoribbon structures	5	Không	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN 0021-8979 (Print)	Có - ISI *IF: 2.236, Q2*	67	106 053710	09/2009
15	Spin-dependent transport in armchair graphene nanoribbons structures with edge roughness effects	5	Không	Journal of Physics: Conferences Series ISSN: 1742-6596		9	193 012100	09/2009
16	Graphene and its one-dimensional patterns: from basic properties towards applications	2	Có	Advanced Natural Science: Nanoscience and Nanotechnology ISSN: 2043-6262		23	2 033001	10/2010
17	Negative differential resistance in zigzag-edge	2	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-	Có - ISI *IF:*	74	107	03/201

	graphene nanoribbon junctions			7550 (Online) ISSN 0021-8979 (Print)	*2.264, Q2*		063705	0
18	Modelling of metal-graphene coupling and its influence on transport properties in graphene at the charge neutrality point	2	Có	Journal of Physics: Condensed Matter ISSN: 1361-648X	Có - ISI *IF: 2.332, Q2*	20	22 425301	09/2010
19	One-dimensional protuberant optically active ZnO structure fabricated by oxidizing ZnS nanowires	6	Có	Materials Letters ISSN: 0167-577X (Print) ISSN: 1873-4979 (Online)	Có - ISI *IF: 2.117, Q2*	20	64 1650	07/2010
20	Transport characteristics of graphene-metal interfaces	2	Có	Applied Physics Letters ISSN: 0003-6951 (Print) ISSN: 1077-3118 (Online)	Có - ISI *IF: 4.23, Q1*	18	101 161605	10/2012
21	Non-equilibrium Green function method: theory and application in simulation of nanometer electronic devices	1	Có	Advanced Natural Science: Nanoscience and Nanotechnology ISSN: 2043-6262	Có - Scopus *IF: 0.474, Q2*	60	5 033001	06/2014
22	Effects of temperature, doping and anisotropy of energy surfaces on behaviors of plasmons in graphene	5	Có	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures ISSN: 1386-9477 (Print) ISSN: 1873-1759 (Online)	Có - Scopus *IF: 2.137, Q2*	5	58 101	12/2013
23	Optical properties of graphene superlattices	4	Có	Journal of Physics: Condensed Matter ISSN: 1361-648X	Có - ISI *IF: 2.346, Q2*	10	26 405304	09/2014
24	On the non-linear effects in graphene	8	Không	Journal of Physics D-Applied Physics ISSN:	Có - ISI *IF: 2.721, Q1*	2	47 094007	02/2014

	devices			1361-6463				
25	Anomalous confined electron states in graphene superlattices	3	Có	Applied Physics Letters ISSN: 0003-6951 (Print) ISSN: 1077-3118 (Online)	Có - ISI *IF: 3.694, Q1*	-26	105 013512	07/2014
26	Effects of carbon on optical properties of ZnO powder	6	Không	Journal of Luminescence ISSN 0022-2313	Có - ISI *IF: .822, Q2*	38	174 6	06/2016
27	Inequivalent effect of Dirac valleys on low-energy plasmonics in heavily doped graphene	4	Có	Physica Status Solidi B: Basic Research ISSN:1521-3951 (Online) ISSN:0370-1972 (Print)	Có - Scopus *IF: 1.722, Q1*		253 1186	02/2016
Sau khi được công nhận PGS/TS								
28	Real-space and plane-wave hybrid method for electronic structure calculations for two-dimensional materials	3	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.84, Q1*	5	95 165130	04/2017
29	Electronic structure and optical properties of twisted bilayer graphene calculated via time evolution of states in real space	2	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.693, Q1*	12	97 125136	03/2018
30	Real-space approach for the electronic calculation of twisted bilayer graphene using the orthogonal polynomial technique	5	Có	Communications in Physics ISSN 0886-3166 (print), ISSN 2815-5947 (online)		5	29 455	11/2019

31	Theoretical considerations on the optimal performance of sub-100 nanomete top-gated graphene field-effect transistors	3	Có	Journal of Electronic Materials ISSN/eISSN: 0361-5235/1543-186X	Có - ISI *IF: 1.895, Q2*		48 1669	01/2019
32	Time-evolution patterns of electrons in twisted bilayer graphene	3	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.613, Q1*	-14	99 165127	04/2019
33	Optical Hall response of bilayer graphene: Manifestation of chiral hybridized states in broken mirror symmetry lattices Electronic properties of slid bilayer graphene: effective models in low energy range	4	Có	Physical Review Research ISSN: 2643-1564 (Online)	Có - ISI *IF: 4.485*	8	2 043281	11/2020
34	Electronic properties of slid bilayer graphene: effective models in low energy range	4	Có	European Physical Journal B ISSN: 1434-6036 (Online) ISSN: 1434-6028 (Print)	Có - ISI *IF: 1.511, Q3*	3	93 190	10/2020
35	Proof for the electronic band crossing in sliding bilayer graphene	1	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.778, Q1*	6	104 205121	11/2021
36	Theory for constructing effective electronic models of	2	Có	Journal of Applied Physics ISSN 1089-7550 (Online) ISSN	Có - ISI *IF: 3.141, Q2*		133 075102	02/2023

	bilayer graphene systems			0021-8979 (Print)				
37	Optical activity and transport in twisted bilayer graphene: Spatial dispersion effects	2	Có	Physical Review B ISSN 2469-9969 (online), 2469-9950 (print)	Có - ISI *IF: 3.621, Q1*	8	107 195141	05/2023
38	Effects of divcancies on the electronic properties of zigzag-edge buckling silicence nanoribbons	7	Không	Physica B: Condensed Matter ISSN: 0921-4526 (Print) ISSN: 1873-2135 (Online)	Có - ISI *IF: 2.884, Q2*	1	670 415390	10/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 9 ([28] [29] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố *(Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)*

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	Chủ trì	Quyết định số 274/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV ngày 24 tháng 7 năm 2020	Trường Đại học Phenikaa	Quyết định số 1536/QĐ-ĐHP-SĐH ngày 28/11/2022	Thẩm định ngày 22/08/2020 theo QĐ 314/QĐ-ĐHP-ĐT&QLSV ngày 17/08/2020

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):
- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

tp. Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Văn Nam.